

для спонтанного момента является точным в пределе  $d \rightarrow \infty$  или  $z \rightarrow \infty$ . Для Х. м. формулировка этого предела оказывается нетривиальной; Метцнером и Фолхардтом [3] показано, что в этом пределе все вычисления сильно упрощаются, при этом сохраняются все физ. свойства модели. Эти упрощения в пределе  $d \rightarrow \infty$  обусловлены тем, что собственная энергия электрона становится диагональной в узельном представлении:

$$\sum_{ij}(\omega) = \sum(\omega)\delta_{ij}, \quad (6)$$

т. е.  $\Sigma$  не зависит от квазимпульса, а является только ф-цией частоты. Одновременно оказывается, что во всех вершинных частях диаграммной техники можно пренебречь законом сохранения квазимпульса, т. е. заменить соответствующую  $\delta$ -функцию на 1. При выполнении предела  $d \rightarrow \infty$  для Х. м. необходимо соответствующим образом масштабировать параметры гамильтониана:

$$t = t^*/2\sqrt{d}, \quad t^* = \text{const}. \quad (7)$$

Тогда спектру (2) в пределе  $d \rightarrow \infty$  соответствует плотность состояний

$$\rho_0(\omega) = \frac{1}{t^*\sqrt{\pi}} e^{-\omega^2/(t^*)^2}, \quad (8)$$

а ср. квадрат энергии  $\delta^2(k)$  в спектре (8) становится конечным в пределе  $d \rightarrow \infty$ . Кроме того, ф-ции Грина на решётке

$$G_{ij}^0(\omega) = \frac{1}{N} \sum_k \frac{e^{ik(R_i - R_j)}}{\omega - \delta(k)} \quad (9)$$

имеют асимптотику  $\sim (1/\sqrt{d})^{|i-j|}$ , где  $|i-j|$  — мин. число шагов по ближайшим соседям (единицах параметра решётки) между узлами  $i$  и  $j$ . В частности, для ближайших соседей  $G_{ij}^0 \sim 1/\sqrt{d}$ . Т. о., в пределе  $d \rightarrow \infty$  все Van-Хова особенности в плотности состояний сглаживаются.

Благодаря локальному характеру собственной энергии в пределе  $d \rightarrow \infty$  Х. м. сводится к однопримесной задаче в решётке [4—7] со специально подобранными двумя ф-циями энергии  $\Sigma(\omega)$  и  $\mathcal{G}(\omega)$ , характеризующими эфф. однородную среду, к-рые в случае магн. упорядочения зависят ещё и от спина.  $\Sigma(\omega)$  играет роль нек-рого эф. поля, действующего на электрон со стороны всех др. электронов, а  $\mathcal{G}(\omega)$  является затравочным линейным пропагатором для  $G_{ii}(\omega)$ . Т. о., имеются два выражения для  $G_{ii}(\omega)$ :

$$G_{ii}(\omega) = \int d\varepsilon \frac{\rho_0(\varepsilon)}{\omega - \varepsilon - \Sigma(\varepsilon)}, \quad (10)$$

$$G_{ii}(\omega) = [\mathcal{G}^{-1}(\omega) - \Sigma(\omega)]^{-1}, \quad (11)$$

приводящие к ур-нию, связывающему  $\Sigma(\omega)$  и  $\mathcal{G}(\omega)$ . С др. стороны, величина  $G_{ii}(\omega)$  как ф-ция Грина однопримесной модели может быть найдена численно (напр., с помощью квантового Монте-Карло метода). В этом смысле ур-ния (10) и (11) представляют точное решение Х. м. в пределе  $d \rightarrow \infty$ , выражая результат через точное решение однопримесной модели. Имеется и др. способ исследовать Х. м. в пределе  $d \rightarrow \infty$  [4] на основе известных выражений для затравочной ф-ции Грина  $\mathcal{G}(\omega)$  однопримесной Х. м. Различный характер поведения  $\mathcal{G}(\omega)$  в зависимости от соотношения между параметрами однопримесной модели определяет возможные режимы для точного однопримесного пропагатора  $G_{ii}(\omega)$ , а следовательно, и характер решения для Х. м. Плотность состояний  $\rho(\omega)$  даётся ф-лой

$$\rho(\omega) = -\frac{1}{\pi} \text{Im } G_{ii}(\omega). \quad (12)$$

возможная структура  $\rho(\omega)$  определяется характером решения однопримесной задачи, т. е. поведением ф-ции Грина  $G_{ii}(\omega)$  модели Андерсона. Затравочная ф-ция Грина  $(\omega)$  для этой модели содержит два независимых параметра — атомный уровень  $E_d$  состояния  $E_d$  и ширину этого уровня  $\Delta$ . В зависимости от соотношения между ними

плотность состояний однопримесной модели имеет двухпиковую структуру (при  $E_d \ll \Delta$ ), один широкий пик (при  $E_d \gg \Delta$ ) или узкий пик, соответствующий электронному резонансу в Кондо эффекте, наряду с одним или двумя широкими сателлитами (при  $|E_d| \sim \Delta$ ). Этим трем режимам однопримесной модели соответствуют три возможных режима Х. м. вблизи половинного заполнения: расщеплённый на две подзоны спектр, нерасщеплённый спектр и спектр с резонансом Кондо на поверхности Ферми. Подобный перенос свойств однопримесной модели Андерсона на Х. м. хорошо подтверждается численными расчёты. На рис. 2 показана эволюция плотности со-

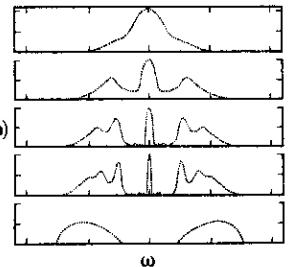


Рис. 2. Плотность состояний  $\rho(\omega)$  для Хаббарда модели при половинном заполнении и  $T=0$  в пределе  $d \rightarrow \infty$  для значений  $U$  (сверху вниз): 1; 2.3; 2.7; 3; 4 [5].

стояний Х. м. с увеличением параметра  $U$ . При  $U \gtrsim 3$  появляется щель в спектре, отвечающая фазовому переходу. В отличие от результатов приближения «Хаббард-3» (рис. 1), появляется узкий квазичастичный пик на поверхности Ферми в металлич. фазе, соответствующий кондо-резонансу, с шириной порядка темп-ры Кондо  $T_K$ . Высота этого центр. пика не меняется с ростом  $U$  вплоть до критич. значения  $U_c$ , когда он исчезает скачком и открывается щель на поверхности Ферми. При  $U > U_c$  в диэлектич. фазе возникает антиферромагн. упорядочение с волновым вектором  $Q$  и локализованными магн. моментами. Металлич. фаза имеет ферми-жидкостное поведение с тяжёлыми фермионами, масса к-рых возрастает по мере приближения к границам диэлектич. фазы. Ожидаемая фазовая диаграмма при половинном заполнении показана на рис. 3, где заштрихована грубо оценённая переходная

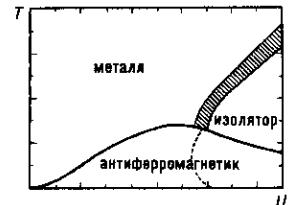


Рис. 3. Фазовая диаграмма при  $n=1$  и  $d \rightarrow \infty$  на плоскости  $(T, U)$  [6].

область от металла к изолятру, в к-рой нарушается ферми-жидкостная картина, т. е. исчезает скачок в  $n_k$  на поверхности Ферми.

При отклонении от половинного заполнения диэлектич. фаза быстро заменяется металлической. В частности, на поверхности Ферми при низких темп-рах возникают узкие резонансы, соответствующие кондовской экранировке локализованных магн. моментов, и при  $n < 0.8$  система ведёт себя как обычная ферми-жидкость. Возможная фазовая диаграмма на плоскости  $(n, U)$  показана на рис. 4.

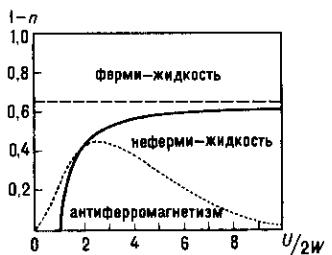


Рис. 4. Фазовая диаграмма при  $T=0$  на плоскости  $(n, U)$  [7].